

高速ECL256字×1位随机存储器

摘要点击: 1785 全文下载: 969

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

所在位置: 1980, 1(1): 54-64

中文关键词:

英文关键词:

基金项目:

PACC代码:

EEACC代码:

作者

单位

[张敏](#)

[陈业新](#)

[杨华丽](#)

[罗杏珍](#)

中文摘要:

高速 ECL 256字×1位随机存储器是在改进设计以及采用漂发射区、双层金属布线等工艺基础上得到的.地址取数时间典型值为12毫秒,读写周期为22 毫秒,功耗500毫瓦,可靠性高、这个器件能在环境温度-55-+150℃以及电源电压-3.5--7.0伏范围内正常工作.本文介绍了在线路和版图设计以及制造工艺方面的特点.

英文摘要:

您是第695017位访问者

主办单位: 中国电子学会, 中国科学院半导体研究所 单位地址: 北京市海淀区清华东路甲35号

Service Tel: 010-82304277, 82304311 Fax: 010-82305052 邮编: 100083 Email: cjs@semi.ac.cn

本系统由勤云电子有限公司设计,技术支持电话: 010-81928386, Email: et_yehu@yahoo.com.cn, 网址: <http://www.e-tiller.com>